

M2TKI-1200-17K

IGBT
модули

www.elvpr.ru

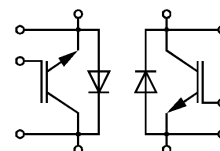
СИЛОВОЙ IGBT МОДУЛЬ

- ◆ полумост
- ◆ кристаллы IGBT IV поколения с вертикальным каналом (trench gate)
- ◆ встроенные быстродействующие диоды обратного тока (EmCon Fast diodes)
- ◆ сверхнизкие потери в открытом состоянии
- ◆ корпус с изолированным основанием
- ◆ диагностические выводы коллектора для контроля V_{CE}



ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ◆ преобразователи частоты
- ◆ источники бесперебойного питания
- ◆ сварочное оборудование
- ◆ ПЧН подвижного состава железных дорог



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

- ◆ $V_{CES} = \underline{1700 \text{ В}}$
- ◆ $I_C = \underline{1200 \text{ А}}$ ($T_C = 80 \text{ °C}$)
- ◆ $V_{CEsat} = \underline{2.00 \text{ В}}$ (тип.)
- ◆ $I_{Cpuls} = \underline{2400 \text{ А}}$ ($T_C = 80 \text{ °C}$)

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Наименование параметра	Условное обозначение	Значение параметра	Единица измерения
Напряжение коллектор-эмиттер	V_{CE}	1700	В
Напряжение затвор-эмиттер	V_{GE}	± 20	
Постоянный ток коллектора	I_C	при $T_C = 25 \text{ °C}$	А
		при $T_C = 80 \text{ °C}$	
Импульсный ток коллектора ($t_p = 1 \text{ мс}$)	I_{Cpuls}	2400	
Постоянный прямой ток диода обратного тока	I_F	1200	
Повторяющийся импульсный прямой ток диода обратного тока	I_{FRM}	2400	
Суммарная мощность рассеивания, IGBT (на один ключ, $T_C = 25 \text{ °C}$)	P_{tot}	5950	Вт
Максимальная температура перехода	T_j	+ 150	°C
Температура хранения	T_{stg}	- 50...+ 125	
Напряжение изоляции ($t = 1 \text{ мин.}$)	V_{isol}	4000	В (эфф)
Защитный показатель диода ($t_p = 10 \text{ мс}$, $V_R = 0 \text{ В}$, $T_C = 125 \text{ °C}$)	I^2t	240	кА ² с

M2TKI-1200-17K

ТЕПЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметра	Условное обозначение	Значение параметра	Единица измерения
Тепловое сопротивление переход-корпус, IGBT (на один ключ)	R_{thjc}	≤ 0.021	°C/Вт
Тепловое сопротивление переход-корпус, диод обратного тока (на один ключ)	R_{thjcD}	≤ 0.048	
Тепловое сопротивление корпус-охладитель, $\lambda_{paste} = 1$ Вт/м · °C, на модуль (типичное значение)	R_{thck}	0.006	°C/Вт

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (при 25 °C, если не указано иное значение)

Наименование параметра	Условное обозначение	Значение параметра			Единица измерения
		мин.	тип.	макс.	
Статические характеристики					
Пороговое напряжение затвор-эмиттер ($V_{GE} = V_{CE}, I_C = 48$ мА)	$V_{GE(th)}$	5.2	5.8	6.4	В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер ($V_{GE} = 15$ В, $I_C = 1200$ А) при $T_j = 25$ °C при $T_j = 125$ °C	V_{CESat}	- -	2.00 2.40	2.45 -	
Ток утечки коллектор-эмиттер ($V_{CE} = 1700$ В, $V_{GE} = 0$ В) при $T_j = 25$ °C	I_{CES}	-	-	5	мА
Ток утечки затвор-эмиттер ($V_{GE} = 20$ В, $V_{CE} = 0$ В)	I_{GES}	-	-	400	нА
Характеристики на переменном токе					
Входная емкость ($V_{CE} = 25$ В, $V_{GE} = 0$ В, $f = 1$ МГц)	C_{ies}	-	110	-	нФ
Обратная переходная емкость ($V_{CE} = 25$ В, $V_{GE} = 0$ В, $f = 1$ МГц)	C_{res}	-	3.5	-	
Заряд затвора ($V_{GE} = \pm 15$ В)	Q_G	-	14	-	мкКл
Характеристики переключения (индуктивная нагрузка, при $T_j = 125$ °C)					
Время задержки включения ($V_{CC} = 900$ В, $V_{GE} = \pm 15$ В, $I_C = 1200$ А, $R_G = 1.2$ Ом) при $T_j = 25$ °C при $T_j = 125$ °C	$t_{d(on)}$	- -	0.74 0.80	- -	мкс
Время нарастания ($V_{CC} = 900$ В, $V_{GE} = \pm 15$ В, $I_C = 1200$ А, $R_G = 1.2$ Ом) при $T_j = 25$ °C при $T_j = 125$ °C	t_r	- -	0.20 0.25	- -	



M2TKI-1200-17K

Время задержки выключения $V_{CC} = 900 \text{ В}, V_{GE} = \pm 15 \text{ В}, I_C = 1200 \text{ А}, R_G = 1.5 \text{ Ом}$ при $T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ при $T_j = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	$t_{d(off)}$	-	1.45	-	
		-	1.80	-	
Время спада $V_{CC} = 900 \text{ В}, V_{GE} = \pm 15 \text{ В}, I_C = 1200 \text{ А}, R_G = 1.5 \text{ Ом}$ при $T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ при $T_j = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	t_f	-	0.18	-	
		-	0.30	-	
Энергия потерь при включении $(V_{CC} = 900 \text{ В}, V_{GE} = \pm 15 \text{ В}, I_C = 1200 \text{ А}, R_G = 1.2 \text{ Ом}, L_S = 50 \text{ нГн}, \text{ за один импульс})$ $T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ $T_j = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	E_{on}	-	240	-	мДж
		-	350	-	
Энергия потерь при выключении $(V_{CC} = 600 \text{ В}, V_{GE} = \pm 15 \text{ В}, I_C = 1200 \text{ А}, R_G = 1.5 \text{ Ом}, L_S = 50 \text{ нГн}, \text{ за один импульс})$ $T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ $T_j = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	E_{off}	-	305	-	
		-	445	-	
Ток короткого замыкания $(t_p \leq 10 \text{ мкс}, V_{CC} = 1000 \text{ В}, V_{GE} \leq 15 \text{ В}, V_{CEmax} = V_{CES} - L_{\sigma(CE)} \times di/dt, T_j \leq 125 \text{ }^\circ\text{C})$	I_{SC}	-	4800	-	А
Внутренняя индуктивность модуля по цепи коллектор-эмиттер	$L_{\sigma(CE)}$	-	20	-	нГн
Внутреннее сопротивление модуля (кристалл – силовые выводы) $T_C = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	$R_{CC/EE'}$	-	0.37	-	МОм

Характеристики диода обратного тока

Прямое падение напряжения ($I_F = 1200 \text{ А}, V_{GE} = 0 \text{ В}$) при $T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ при $T_j = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	V_F	-	1.8	2.2	В
		-	1.9	-	
Ток обратного восстановления ($I_F = 1200 \text{ А}, V_{GE} = -15 \text{ В}, V_R = 900 \text{ В}, di_F/dt = -7000 \text{ А/мкс}$) при $T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ при $T_j = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	I_{rr}	-	1150	-	А
		-	1250	-	
Время обратного восстановления ($I_F = 1200 \text{ А}, V_{GE} = -15 \text{ В}, V_R = 900 \text{ В}, di_F/dt = -7000 \text{ А/мкс}, T_j = 125 \text{ }^\circ\text{C}$)	t_{rr}	-	0.82	-	мкс
Заряд обратного восстановления ($I_F = 1200 \text{ А}, V_{GE} = -15 \text{ В}, V_R = 900 \text{ В}, di_F/dt = -7000 \text{ А/мкс}$) при $T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ при $T_j = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	Q_{rr}	-	305	-	мкКл
		-	510	-	
Энергия обратного восстановления ($I_F = 1200 \text{ А}, V_{GE} = -15 \text{ В}, V_R = 900 \text{ В}, di_F/dt = -7000 \text{ А/мкс}$) при $T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ при $T_j = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	E_{rec}	-	190	-	мДж
		-	340	-	

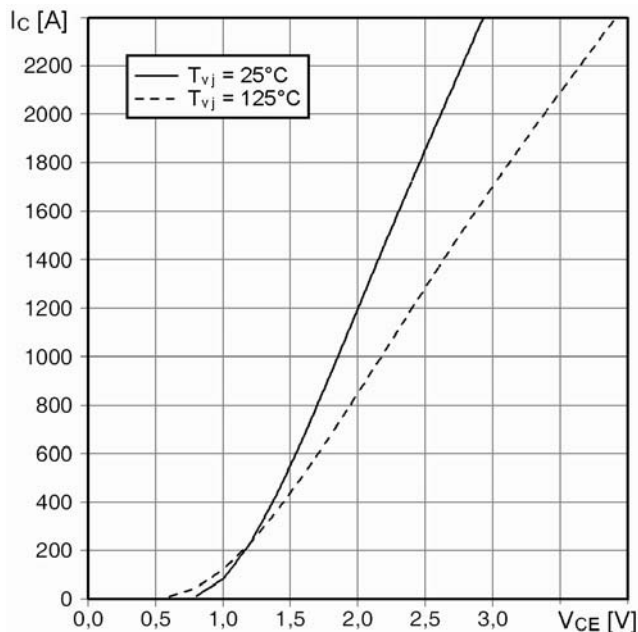


М2ТКИ-1200-17К

Типовые выходные характеристики

$$I_C = f(V_{CE})$$

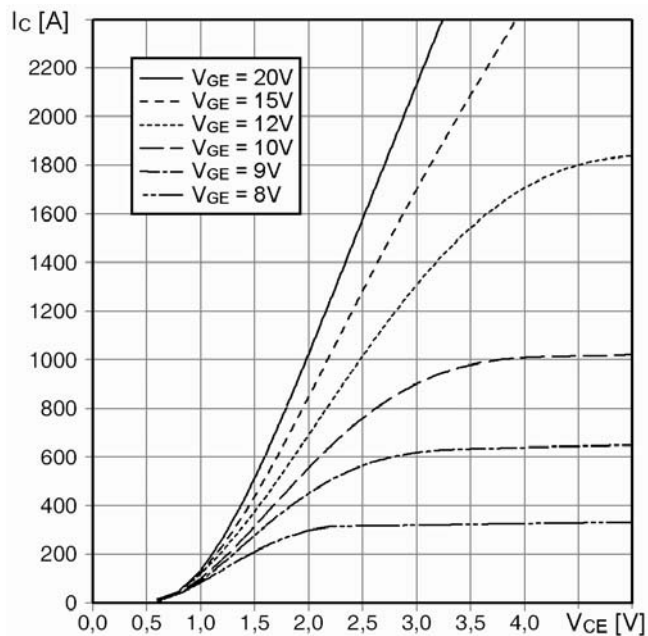
Режим измерения: $V_{GE} = +15\text{ В}$, $T_j = 25, 125\text{ }^\circ\text{C}$



Типовые выходные характеристики

$$I_C = f(V_{CE})$$

Режим измерения: $T_j = 125\text{ }^\circ\text{C}$



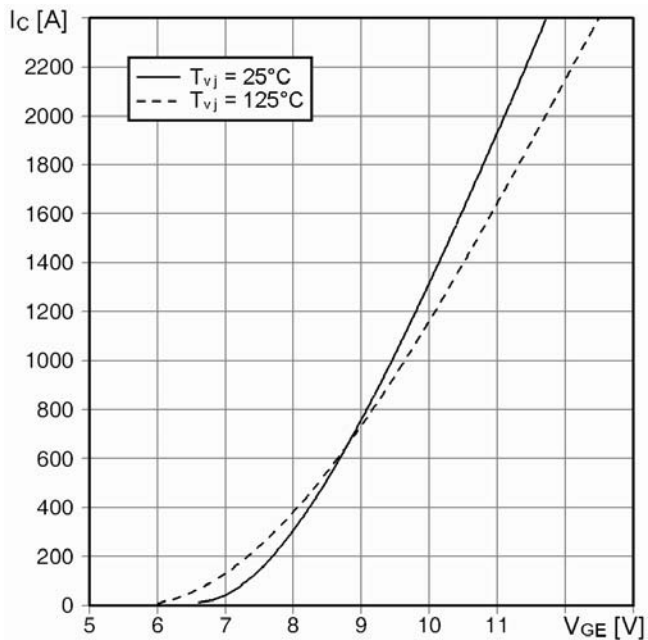


М2ТКИ-1200-17К

Типовые передаточные характеристики

$$I_C = f(V_{GE})$$

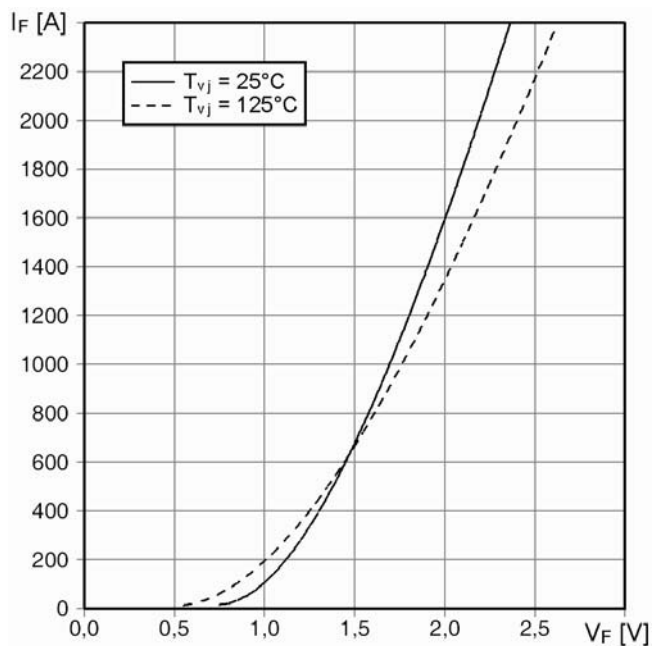
Режим измерения: $V_{CE} = 20 \text{ В}$, $T_j = 25, 125 \text{ }^\circ\text{C}$



Типовые прямые характеристики диода обратного тока

$$I_F = f(V_F)$$

Режим измерения: $T_j = 25, 125 \text{ }^\circ\text{C}$



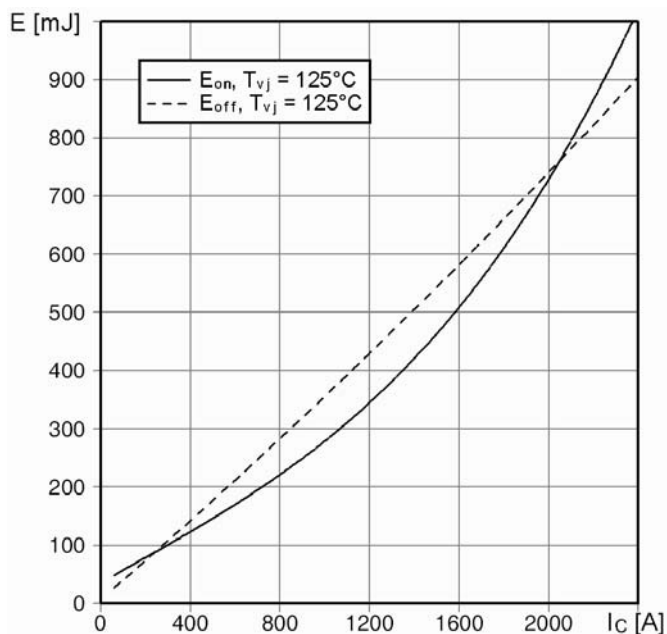


М2ТКИ-1200-17К

Типовые зависимости коммутационных потерь

$E_{off} = f(I_C)$, $E_{on} = f(I_C)$, индуктивная нагрузка

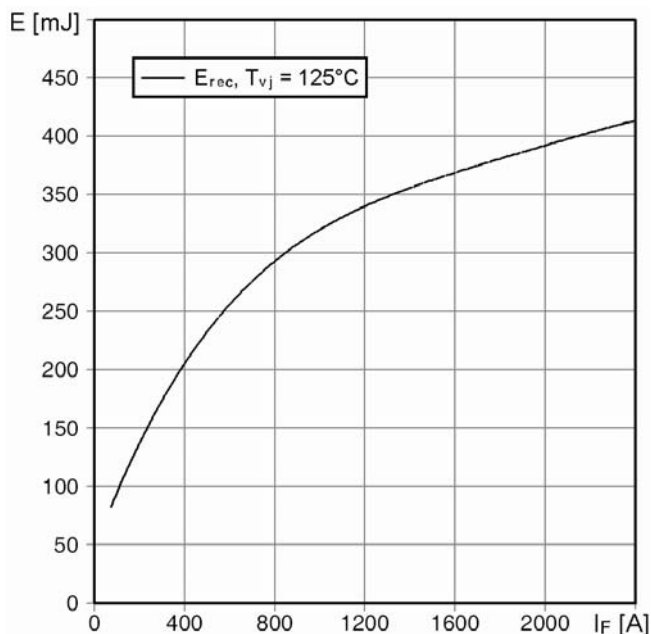
Режим измерения: $V_{CE} = 900$ В, $V_{GE} = \pm 15$ В, $R_{G(on)} = 1.2$ Ом, $R_{G(off)} = 1.5$ Ом, $T_j = 125$ °С



Типовые зависимости коммутационных потерь

$E_{rec} = f(I_F)$, индуктивная нагрузка

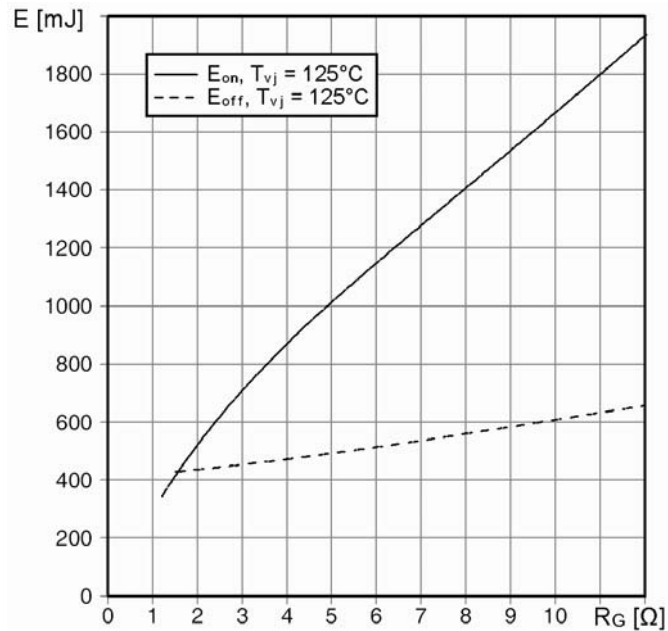
Режим измерения: $V_{CE} = 900$ В, $V_{GE} = \pm 15$ В, $R_{G(on)} = 1.2$ Ом, $R_{G(off)} = 1.5$ Ом, $T_j = 125$ °С



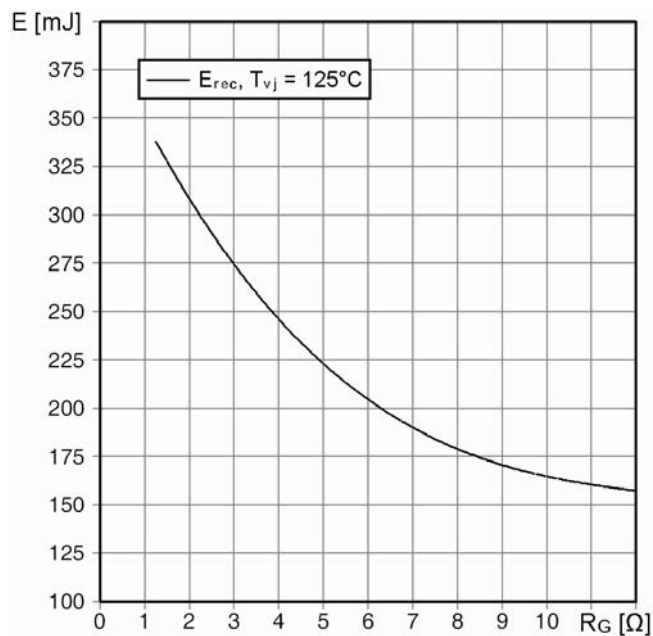


М2ТКИ-1200-17К

Типовая зависимость коммутационных потерь
 $E_{off} = f(R_G)$, $E_{on} = f(R_G)$, индуктивная нагрузка
Режим измерения: $V_{CE} = 900 \text{ В}$, $V_{GE} = \pm 15 \text{ В}$, $T_j = 125 \text{ }^\circ\text{C}$



Типовая зависимость коммутационных потерь
 $E_{rec} = f(R_G)$, индуктивная нагрузка
Режим измерения: $V_{CE} = 900 \text{ В}$, $V_{GE} = \pm 15 \text{ В}$, $T_j = 125 \text{ }^\circ\text{C}$

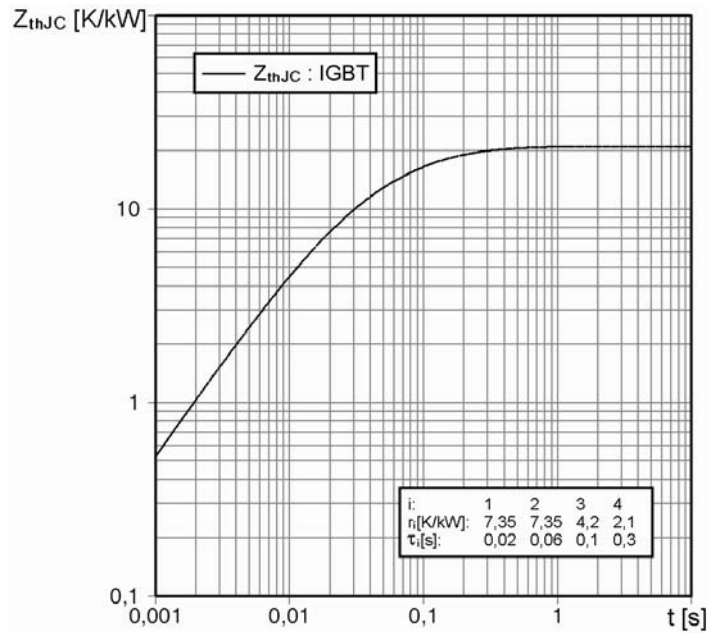




М2ТКИ-1200-17К

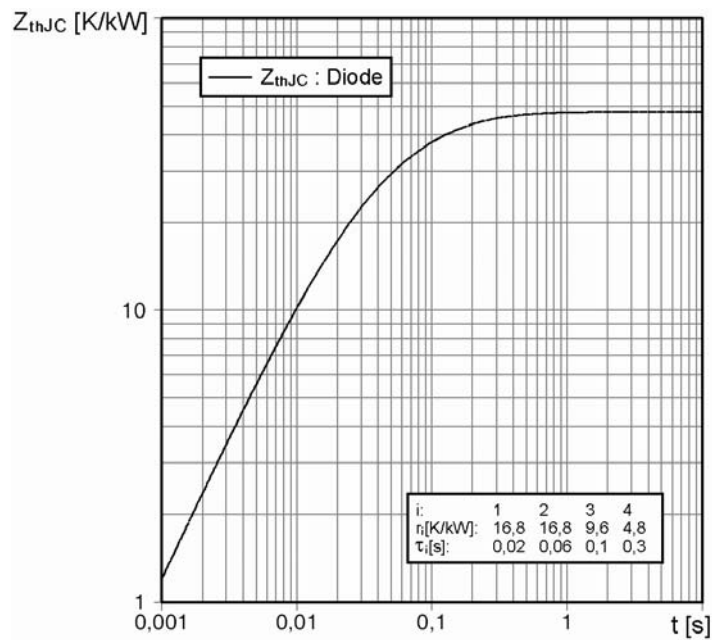
Переходное тепловое сопротивление на IGBT

$$Z_{thjc} = f(t_p)$$



Переходное тепловое сопротивление на диоде

$$Z_{thjc} = f(t_p)$$



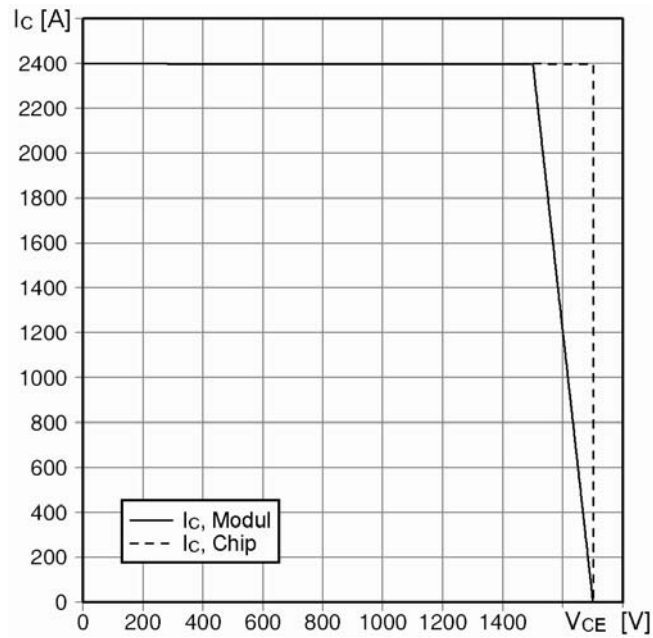


М2ТКИ-1200-17К

Обратная область безопасной работы

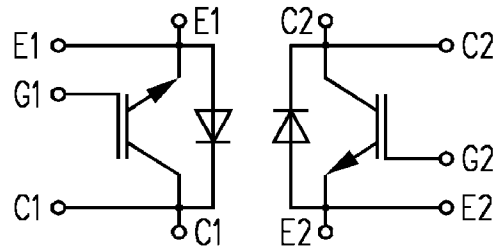
$$I_{C \text{ puls}} = f(V_{CE})$$

Режим измерения: $R_{G(off)} = 1.5 \text{ Ом}$, $V_{LF} = V_{LR} = 15 \text{ В}$, $T_j = 125 \text{ °C}$

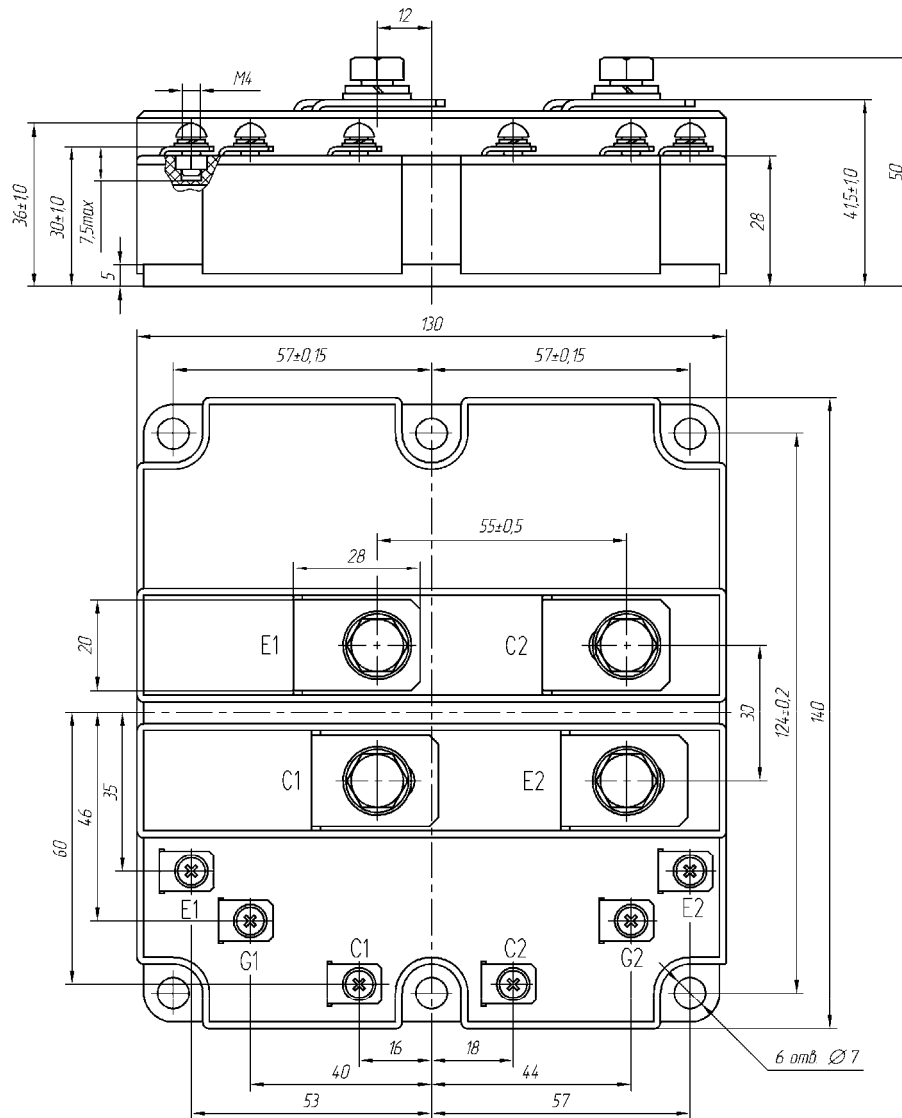


М2ТКИ-1200-17К

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Масса 1.5 кг